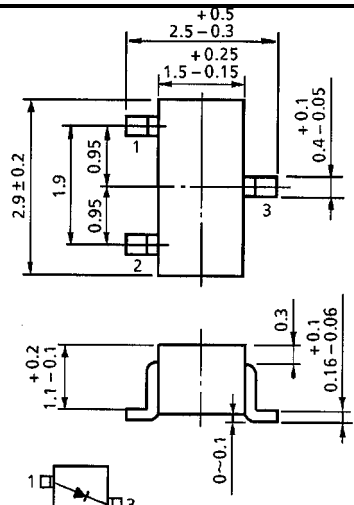
東芝ダイオード　シリコンエピタキシャルショットキバリア形

1SS396

○ 低電圧高速スイッチング用

- 外形が小さい。　　：SC–59
- 順方向電圧が低い。　　：$V_{F\ (3)}$ = 0.54V (標準)
- 逆電流が小さい。　　：I_R = 5 μA (最大)

単位: mm



JEDEC	TO–236MOD
EIAJ	SC–59
東芝	1–3G1G

最大定格 (Ta = 25°C)

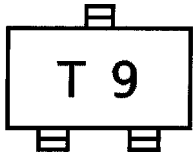
項目	記号	定格	単位
せん頭逆電圧	V_{RM}	45	V
逆電圧	V_R	40	V
せん頭順電流	I_{FM}	300*	mA
平均整流電流	I_O	100*	mA
サージ電流 (10 m s)	I_{FSM}	1*	A
許容損失	P	150	mW
接合温度	T_j	125	°C
保存温度	T_{stg}	−55～125	°C
動作温度	T_{opr}	−40～100	°C

*: ユニット定格です。トータル定格はユニット定格の 70%値です。

電気的特性 (Ta = 25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
順電圧	$V_{F\ (1)}$	I_F = 1mA	—	0.28	—	V
	$V_{F\ (2)}$	I_F = 10mA	—	0.36	—	
	$V_{F\ (3)}$	I_F = 100mA	—	0.54	0.60	
逆電流	I_R	V_R = 40V	—	—	5	μA
端子間容量	C_T	V_R = 0, f = 1MHz	—	18	25	pF

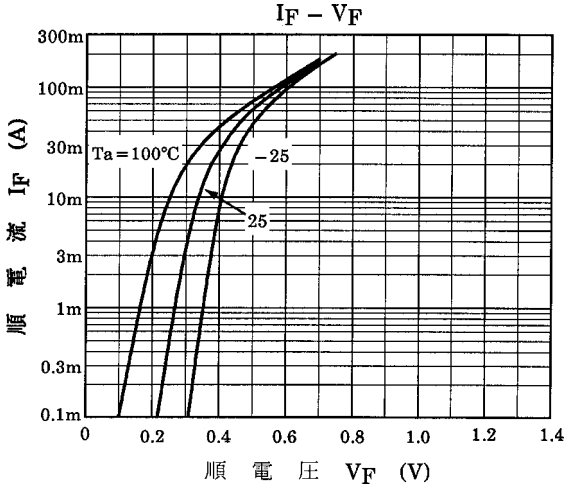
現品表示



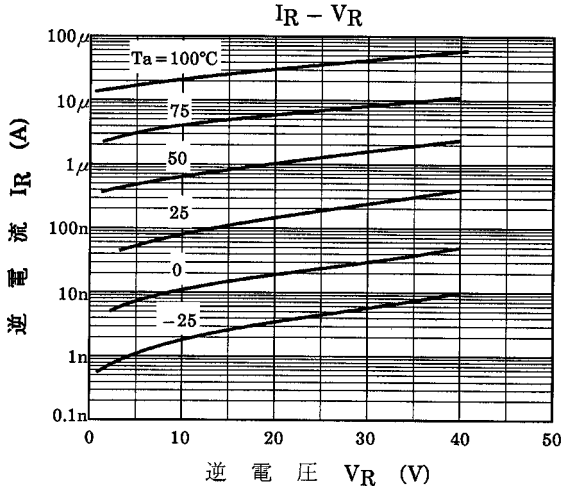
960917TAA1

- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、一般に半導体製品は誤作動したり故障することがあります。当社半導体製品をご使用頂く場合は、半導体製品の誤作動や故障により、他人の生命・身体・財産が侵害されることのないように、購入者側の責任において、装置の安全設計を行うことをお願いします。
  なお、設計に際しては、最新の製品仕様をご確認の上、製品保証範囲内でご使用頂くとともに、考慮されるべき注意事項や条件について「東芝半導体製品の取り扱い上のご注意とお願い」、「半導体信頼性ハンドブック」などをご活用ください。
- 本資料に掲載されている技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社および第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。

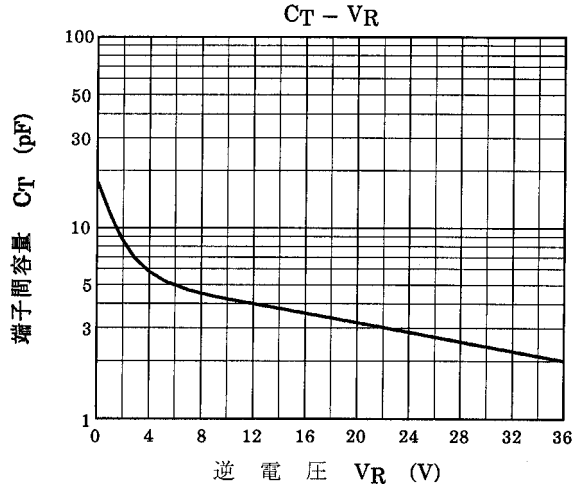
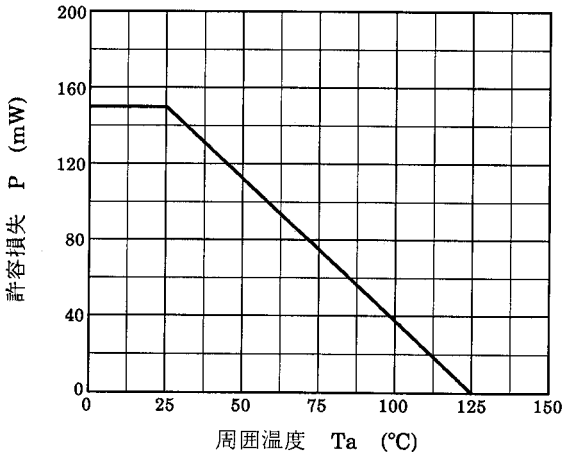
$I_F - V_F$



$I_R - V_R$



$C_T - V_R$



P − Ta